

## ★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 前澤宏一 副委員長 津田邦男  
幹事 鈴木寿一・新井 学 幹事補佐 東脇正高・大石敏之

## ★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 野毛 悟 副委員長 廣瀬文彦  
幹事 小館淳一・岩田展幸 幹事補佐 坂本 尊・中村雄一

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏  
幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也

日時 5月25日(木) 13:30~17:05  
26日(金) 9:30~11:10

会場 名古屋大学 VBL ベンチャーホール (3F) (名古屋市千種区不老町 B2-4. JR 名古屋駅から名古屋市営地下鉄:  
名古屋大学下車 (東山線本山駅乗換, 約 30 分). JR 金山駅から名古屋市営地下鉄: 名古屋大学下車. <http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html> 宮崎誠一)

議題 結晶成長, 評価及びデバイス (化合物, Si, SiGe, 電子・光材料) 及びその他

25日

- フレキシブル基板上室内用有機薄膜太陽電池の作製と評価  
○川松祐介・伊藤瑞起・加藤慎也・曾我哲夫・岸 直希 (名工大)
- 真空蒸着法による SnS 堆積に関する研究 ○高野 泰・菅沼幸雄 (静岡大)
- 電気化学堆積法による NiO 半導体薄膜の作製 ○古山実季・市村正也 (名工大)
- ドロップ光化学堆積法による n 型 AlO<sub>x</sub> 薄膜の作製 ○梅村将成・市村正也 (名工大)
- 電気化学堆積法による Cu 添加 p 型 Fe-O 薄膜半導体の作製 ○小林悟史・市村正也 (名工大)
- 多モード干渉を用いた表面プラズモン論理回路の開発  
○渡邊 領・太田 雅・菊地裕大・平野智裕・石井佑弥・福田光男 (豊橋技科大)
- ボウタイ型金属導波路を用いたプラズモニック保持回路の開発  
○古木崇裕・太田 雅・石井佑弥・福田光男 (豊橋技科大)
- 表面プラズモンを用いた合分波器及び信号反転器の開発  
○中山昂太郎・住村あさひ・外岡悠汰・太田 雅・石井佑弥・福田光男 (豊橋技科大)

26日

- GaSb/Si (111)- $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ -Ga 表面上への InGaSb 薄膜のヘテロエピタキシャル成長  
モハマド モンズール・○森 雅之・下山浩哉・前澤宏一 (富山大)
- 水溶液浸漬による 4H-SiC (0001) Si 面における表面再結合の抑制  
○加藤正史・市川義人・市村正也 (名工大)・木本恒暢 (京大)
- GaN 基板上 GaN エピ層のマイクロ波光導電減衰法による評価 ○浅田貴斗・市川義人 (名工大)・伊藤健治・富田一義・成田哲生 (豊田中研)・加地 徹 (名大)・加藤正史 (名工大)
- N-polar GaN MIS-HEMTs with Flat Interface Grown by Optimized MOVPE  
○Kiattiwut Prasertsuk・Tomoyuki Tanikawa・Takeshi Kimura・Shigeyuki Kuboya・Tetsuya Suemitsu・Takashi Matsuoka (Tohoku Univ.)

◆応用物理学会共催

☆ED 研究会

【問合先】

鈴木寿一 (北陸先端大)  
TEL [0761] 51-1441, FAX [0761] 51-1455  
E-mail: [tosikazu@jaist.ac.jp](mailto:tosikazu@jaist.ac.jp)

☆SDM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

6月20日(火) キャンパス・イノベーションセンター東京 [締切済] テーマ: MOS デバイス・メモリ高性能化—  
材料・プロセス技術 (応用物理学会; シリコンテクノロジー分科会共催)

【問合先】

黒田理人 (東北大)  
TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834  
E-mail: [rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp](mailto:rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp)